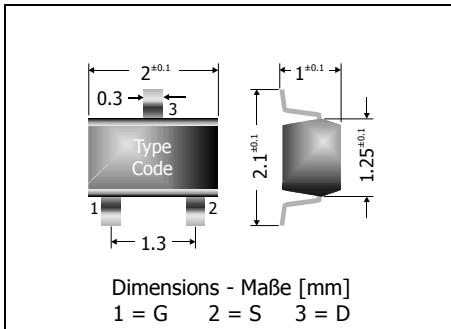


MMFTN3018W**N**
Silicon N-Channel MOS Field Effect Transistor
Silizium N-Kanal MOS Feldeffekt-Transistor
N

Version 2011-01-28



Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case
Kunststoffgehäuse

SOT-323

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform getupet auf Rolle**Maximum ratings (T_A = 25°C)****Grenzwerte (T_A = 25°C)**

		MMFTN3018W	
Drain-Source-voltage – Drain-Source-Spannung	G short	V _{DSS}	60 V
Gate-Source-voltage Continuous – Gate-Source-Spannung		V _{GSS}	± 20 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	200 mW ¹⁾
Drain current continuous – Drainstrom (dc)		I _D	100 mA
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom		I _{DM}	400 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C

1 Device mounted on standard PCB material
Bauteil montiert auf Standard-Leiterplattenmaterial

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung I _D = 10 μA	V _{(BR)DSS}	30 V		
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom V _{DS} = 30 V	G short I _{DSS}			1 μA
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom V _{GS} = 20 V	±I _{GSS}			1 μA
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung V _{DS} = 3 V, I _D = 100 μA	V _{GS(th)}	0.8 V		1.5 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand V _{GS} = 4 V, I _D = 10 mA V _{GS} = 2.5 V, I _D = 1 mA	R _{DS(on)} R _{DS(on)}			8 Ω 13 Ω
Forward Transfer Admittance – Übertragungssteilheit V _{DS} = 3 V, I _D = 10 mA	g _{FS}	20 mS		
Input Capacitance – Eingangskapazität V _{DS} = 5 V, f = 1 MHz	C _{iss}		13 pF	
Output Capacitance – Ausgangskapazität V _{DS} = 5 V, f = 1 MHz	C _{oss}		9 pF	
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität V _{DS} = 5 V, f = 1 MHz	C _{rss}		4 pF	
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 625 K/W ¹⁾		

1 Device mounted on standard PCB material
Bauteil montiert auf Standard-Leiterplattenmaterial